Kure College		Year 2021			Course Title	Electronic de	vice		
Course	Informa	tion							
Course Code 0290					Course Category	/ Specialize	Specialized / Elective		
Class Format Lecture		Lecture			Credits	School Cr	School Credit: 1		
		Electrical E Science	ingineering and	Information	Student Grade	5th	5th		
Term		First Seme	ester Classes p			k 前期:2			
	ktbook and/or aching Materials 石田誠著 集積回路 オーム社								
Instructor Eguchi Eguchi,									
Course	Objectiv	'es							
2. 電子ラ3. 集積四4. 集積四5.	デバイスの碁 回路の基本的 回路の構成で デバイスの碁 ジタル集積 リデバイス	基本動作を理解 りな構造と製造 ヒパターンレイ 基礎と動作	問について把握す する。 方法を理解する。 アウトを理解する						
Rubric									
			理想的な到達レベルの目安 標準		標準的な到達レベ	標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安	
評価項目1			電子デバイスの基本動作を適切に 理解できる		電子デバイスの基本動作を理解で きる		電子デバイスの基本動作を理解で きない		
評価項目2			集積回路の基本的な構造と製造方 法を適切に説明できる		集積回路の基本的な構造と製造方 法を説明できる		集積回路の基本的な構造と製造方 法を説明できない		
評価項目3	}		電子デバイスの に説明できる	基礎と動作を適切	電子デバイスの基 できる	電子デバイスの基礎と動作を説明 できる		電子デバイスの基礎と動作を説明 できない	
Assigne	ed Depar	tment Obje	ectives						
学習・教育	<b>育到達度目</b> 標	票 本科の学習・	教育目標 (HC)						
Teachin	ng Metho	od							
Outline		エレクトロ 電子デバイ 指す。本授	ニクスの発展が, スがある。半導体 業は進学と就職に	今日の情報化社会 物性から電子デバ 関連する。また、	の発展を支え, 今後 イスの構造・動作原 創造力や工夫する力	後の高度情報化社会 理を中心に学習 対(応用力)を育り	会の推進役となる し基本的概念が理 成する。	。その基盤として 解できることを目	
Style				1路と関連づけ講義	する。【新型コロナ	ウィルスの影響	により、授業内容	を一部変更する可	
		能性があり				b. —. — 1. — 34	,		
Notice					のように関係し貢献	tしているかを字。	んでみよつ。		
Charact	eristics	of Class / L	<u> Division in Le</u>	arning	1		1		
☐ Active Learning			☐ Aided by ICT		☐ Applicable to Remote Class ☐ Interpretation		Instructor   Experienced	Instructor Professionally perienced	
Course	Plan								
Course Harr		Т	heme			Goals			
1st Semeste r	1st Quarter		マイスの基礎			デバイスの構造が説明できる			
			子デバイスの基礎			CMOSの電気的特性が説明できる			
			積回路の基礎			スケーリングが説明できる			
			積回路の基礎			集積回路の要素プロセスが説明できる			
		5th 集	積回路の基礎			集積回路の要素プロセスが説明できる			
		6th 集	積回路の基礎			集積回路の要素プロセスが説明できる			
		7th 集				集積回路の製造工程が説明できる			
		8th 集	長積回路の製造工程			パッケージングと実装技術が説明できる			
		9th 電				MEMSの製造工程が説明できる			
	2nd Quarter	10th デ	デジタル集積回路の具体例			CMOSデジタル回路の基本構成素子が説明できる			
		11th デ	デジタル集積回路の具体例			CMOSデジタル回路とマスクパターン設計が説明できる			
		12th メ	メモリデバイス			DRAMが説明できる			
		13th メ	メモリデバイス			SRAM、FLASHが説明できる			
		H	三頼性技術			信頼性の考え方、劣化させる要因が説明できる			
			答案返却・解答説明						
		16th							
Evaluat	ion Meth	nod and We		<b>.</b>		<b>I</b>			
	試		演習	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	Total	
Subtotal 40			0	0	0	60	0	100	
基礎的能力 20			0	0	0	30	0	50	
専門的能力 20			0	0	0	30	0	50	
分野横断的	的能力 0		0	0	0	0	0	0	